



窒化物半導体発光デバイスの最前線

◇日時: 2024年7月2日(火) 10:00~17:30

2024年7月3日(水) 10:00~17:25

◇場所: 京都テルサ 第2・3セミナー室 (京都市南区東九条下殿田町70)

+Zoomによるオンライン **ハイブリッド開催**

窒化物半導体発光デバイスは、結晶成長技術の進展とともに、紫外や緑色・赤色への波長域拡大が、この数年で急速に進んでいます。一方、その背景の物理現象も少しずつ解明されつつあります。この研究会では、1日目は可視光領域、2日目は紫外光領域の発光デバイス開発を主眼に置き、それを支える結晶成長、物性評価も含めて、結晶工学的および電子物性的な観点で議論を行うことを目的として企画されたもので、第一線でご活躍されている方々に下記のプログラムにて招待講演をいただきます。

7月2日(火) 結晶工学分科会第161回研究会

担当幹事: 船戸(京大)、谷川(阪大)

1. 結晶工学分科会 幹事長 挨拶
2. 企画趣旨説明 担当幹事
3. 可視光半導体レーザーとその応用 長濱慎一(日亜化学)
4. Advanced ELO技術を用いた窒化物半導体レーザー 川口佳伸(京セラ)
12:00-13:15 休憩
5. 結晶成長技術を基盤としたInGaN系赤色LEDおよびLDに向けた研究開発 大川和宏(KAUST)
6. 小型超高精細マイクロLEDディスプレイに資するEu添加GaIn赤色LEDの新展開 藤原康文(立命館大)
7. 光電子分光を活用した窒化物半導体表面でのキャリアダイナミクス評価 市川修平(阪大)
15:30-16:00 休憩
8. 自在制御された三次元マイクロ構造による InGaN 系多波長発光デバイスの実現 松田祥伸(京大)
9. 積層型 InGaN フルカラーモノリシックマイクロ LED ディスプレイの開発 五所野尾浩一(豊田合成)

7月3日(水) 応用電子物性分科会研究例会

担当幹事: 山口(金沢工大)、岩谷(名城大)、横関(SONY)

1. 応用電子物性分科会 幹事長 挨拶
2. AlGaInの電気伝導制御:分極と不純物ドーピング 竹内哲也(名城大)
3. 275 nm帯AlGaIn LEDの初期劣化機構 秩父重英(東北大)
11:55-13:00 休憩
4. 深紫外発光AlGaIn系量子井戸構造の光物性 室谷英彰(徳山高専)
5. スパッタ・アニール法AlNテンプレート上へのAlGaIn結晶成長 三宅秀人(三重大)
6. 単結晶AlN基板上230 nm帯 LEDの開発 佐藤恒輔, 小林敬嗣(旭化成)
15:25-15:55 休憩
7. 格子緩和した高品質AlGaIn上に作製したAlGaIn系UV-B領域の半導体レーザー 岩谷素顕(名城大)
8. 単結晶AlN基板上擬似格子整合AlGaIn UV-Cレーザーダイオード 久志本真希(名大)

■受付: 結晶工学分科会webページより事前登録お願いいたします。 <https://annex.jsap.or.jp/kessho/>

■参加費(テキスト代・消費税込): 2日間通して参加いただけます。1日のみの参加でも同額です。

応用電子物性分科会会員もしくは結晶工学分科会会員 6,000円 分科会学生会員 2000円

応用物理学会会員(分科会会員でない場合) 15,000円 シニア会員 5,000円 一般 20,000円 学生 4,000円

[応電分科会賛助会社](#)、[結晶分科会賛助会社](#)の方は、分科会会員と同額とします。

■問合せ先: 山口 敦史(金沢工大) E-mail: yamaguchi[at]neptune.kanazawa-it.ac.jp

船戸 充(京大) E-mail: funato[at]kuee.kyoto-u.ac.jp

白石/吉田(応用物理学会 事務局) TEL: 03-3828-7723(直通) E-mail: divisions[at]jsap.or.jp

※ [at] は @ にお読み替えてください